

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】令和 3 年 4 月 1 日 (2021.4.1)

【公開番号】特開 2019-12684 (P2019-12684A)

【公開日】平成 31 年 1 月 24 日 (2019.1.24)

【年通号数】公開・登録公報 2019-003

【出願番号】特願 2018-40943 (P2018-40943)

【国際特許分類】

H 0 5 B 33/22 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 1 L 27/32 (2006.01)

H 0 5 B 33/12 (2006.01)

H 0 5 B 33/26 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

G 0 9 F 9/00 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/22 Z

H 0 5 B 33/14 A

H 0 1 L 27/32

H 0 5 B 33/12 B

H 0 5 B 33/26 Z

H 0 5 B 33/10

G 0 9 F 9/30 3 4 8 Z

G 0 9 F 9/30 3 6 5

G 0 9 F 9/00 3 3 8

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 2 月 8 日 (2021.2.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 1】

図 2 D は、図 2 C が示す構成から、画素定義層 2 5 3 及び凸状構造部 2 5 7 R B より上層を除いた部分の断面図である。画素定義層 2 5 3 は、溝 2 5 5 R B 内に、側面（第 1 側面）5 3 1 R 及び側面（第 2 側面）5 3 1 B を有する。側面 5 3 1 R、5 3 1 B は、溝 2 5 5 R B の内面である。側面 5 3 1 R は、赤の副画素 2 5 1 R 側の側面であり、側面 5 3 1 B は、青の副画素 2 5 1 B 側の側面である。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 8 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 8 8】

以下において、行方向又は列方向に隣接する副画素を、軸隣接する副画素と呼ぶ。斜め歩行に隣接する副画素を、斜め隣接する副画素と呼ぶ。軸隣接する副画素からなる各副画素ペアにおいて、副画素間に島状の凸状構造部が配置されている。軸隣接する凸状構造部

の間には、ギャップが存在する。例えば、凸状構造部 2 5 7 G R 1 と凸状構造部 2 5 7 G R 2 との間にギャップが存在し、凸状構造部 2 5 7 G G と凸状構造部 2 5 7 R R との間にギャップが存在する。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 0 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 1 0 2】

図 8 A は、画素定義層の一部と凸状構造部との間、さらに、凸状構造部の全面に形成された、M g A g 層を示す平面図を示す。図 8 B は、図 8 A における V I I I B - V I I I B 切断線での断面図を示す。なお、M g A g 層は、実際には、画素定義層 1 2 5 3 L、画素定義層 1 2 5 3 R の斜面部分の一部まで覆われるが、図面では説明の便宜のため省略している。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 6】

請求項 1 に記載の O L E D 表示装置であって、
前記複数の副画素の上部電極それぞれは、連続した一つの電極層の一部であり、
前記複数の副画素の中間層はそれぞれ同一層の部分であり、
前記第 3 側面及び前記第 4 側面の少なくとも一方において、前記第 1 副画素と前記第 2 副画素との間において中間層が切断されている、O L E D 表示装置。